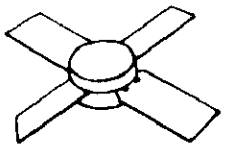
SGS-THOMSON MICROELECTRONICS

SD1530-01

RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS

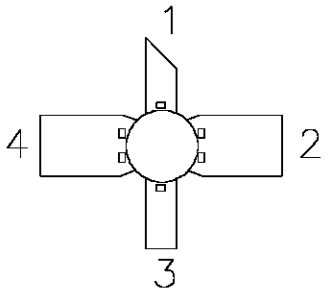
- DESIGNED FOR HIGH POWER PULSED IFF, DME, TACAN APPLICATIONS
- 40 WATTS (typ.) IFF 1030 - 1090 MHz
- 35 WATTS (min.) DME 1025 - 1150 MHz
- 25 WATTS (typ.) TACAN 960 - 1215 MHz
- 9.0 dB MIN. GAIN
- REFRACTORY GOLD METALLIZATION
- EMITTER BALLASTING AND LOW THERMAL RESISTANCE FOR RELIABILITY AND RUGGEDNESS
- INFINITE LOAD VSWR CAPABILITY AT SPECIFIED OPERATING CONDITIONS
- INPUT MATCHED, COMMON BASE CONFIGURATION



.280 4LSL (M115)
epoxy sealed

ORDER CODE	BRANDING
SD1530-01	1530-1

PIN CONNECTION



1. Collector
2. Base
3. Emitter
4. Base

DESCRIPTION

The SD1530-01 is a gold metallized silicon, NPN power transistor designed for applications requiring high peak power and low duty cycles such as IFF, DME and TACAN. The SD1530-01 is packaged in the .280" input matched stripline package resulting in improved broadband performance and a low thermal resistance.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_{case} = 25°C)

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	65	V
V_{CES}	Collector-Emitter Voltage	65	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	3.5	V
I_C	Device Current	2.6	A
P_{DISS}	Power Dissipation	87.5	W
T_J	Junction Temperature	+200	°C
T_{STG}	Storage Temperature	– 65 to +150	°C

THERMAL DATA

$R_{TH(j-c)}$	Junction-Case Thermal Resistance	2.0	°C/W

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (T_{case} = 25°C)

STATIC

Symbol	Test Conditions		Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
BV_{CBO}	I_C = 20mA	I_E = 0mA	60	—	—	V
BV_{CES}	I_C = 20mA	V_{BE} = 0V	60	—	—	V
BV_{EBO}	I_E = 2mA	I_C = 0mA	3.5	—	—	V
I_{CBO}	V_{CB} = 50V	I_E = 0mA	—	—	2	mA
h_{FE}	V_{CB} = 5V	I_C = .5A				

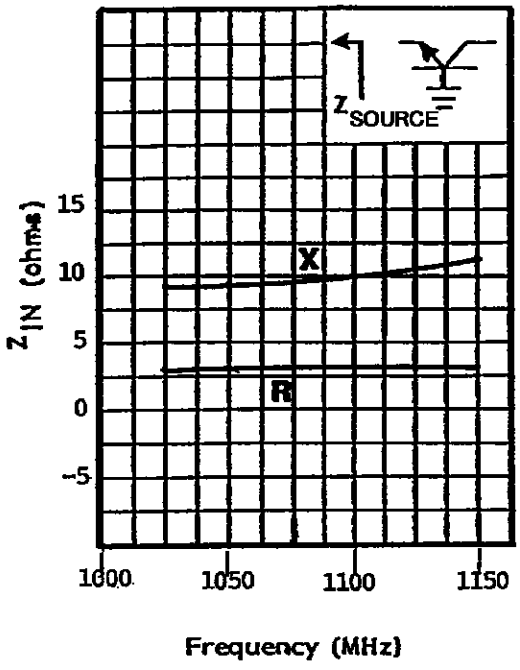
DYNAMIC

Symbol	Test Conditions			Value			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
P_{OUT}	f = 1025 – 1150MHz	P_{IN} = 5.6 W	V_{CE} = 50 V	35	—	—	W
G_P	f = 1025 – 1150MHz	P_{IN} = 5.6 W	V_{CE} = 50 V	9.0	—	—	dB

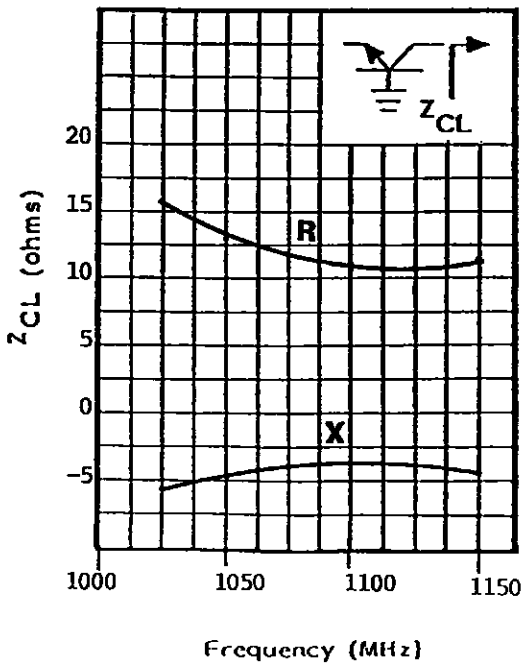
Note: Pulse Width = 10μSec, Duty Cycle = 1%
This device is suitable for use under other pulse width/duty cycle conditions.
Please contact the factory for specific applications assistance.

IMPEDANCE DATA

TYPICAL INPUT IMPEDANCE

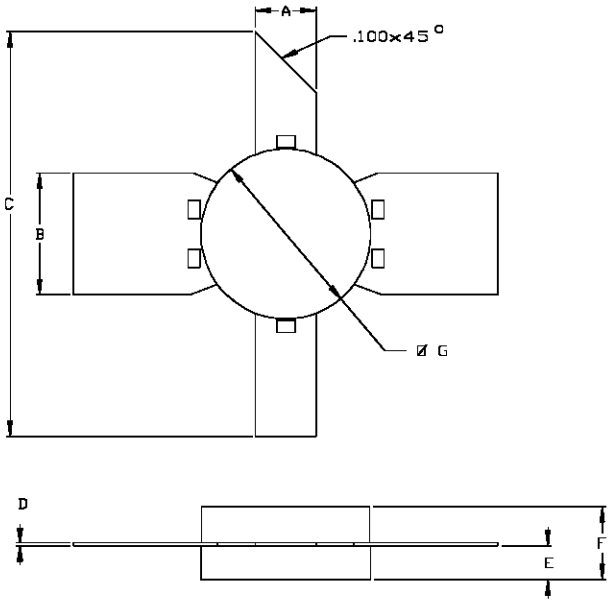


TYPICAL COLLECTOR LOAD IMPEDANCE



PACKAGE MECHANICAL DATA

Ref.: Dwg. No.12-0115



SGS-THOMSON MICROELECTRONICS		
	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.095/2,41	.105/2,67
B	.195/4,95	.205/5,21
C	1.000/25,40	
D	.004/0,10	.007/0,18
E	.050/1,27	.065/1,65
F		.145/3,68
G	.275/6,99	.285/7,21

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9